**Сведения о ведущей организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование ведущей организации | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук  ИПТМ РАН |
| Адрес | 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6. |
| Телефон | +7 (495) 962-80-74 |
| Адрес электронной почты | general@ipmt-hpm.ac.ru |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) | http://www.iptm.ru/new/index.ru.html |
| Список основных публикаций работников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15). | Soltanovich, Oleg A. ; Orlov, Valery, I ; Yarykin, Nikolai; Yakimov, Eugene B. Room‐Temperature Ni Interaction with Deformation‐Induced Defects in Si: A DLTS Study //physica status solidi (a). – 2019. – Т. 216. – №. 17. – С. 1900326Polyakov, A. Y. ; Lee, In-Hwan ; Smirnov, N. B.; Yakimov, E. B.; Shchemerov, I., V; Chernykh, A., V; Kochkova, A., I; Vasilev, A. A.; Carey, P. H.; Ren, F.; Smith, David J.; Pearton, S. J. Defects at the surface of β-Ga2O3 produced by Ar plasma exposure //APL Materials. – 2019. – Т. 7. – №. 6. – С. 061102.Polyakov, A. Y. ; Smirnov, N. B. ; Schemerov, I. V.; Chernykh, A. V.; Yakimov, E. B.; Kochkova, A. I.; Yang, Jiancheng; Fares, Chaker; Ren, F.; Pearton, S. J. Deep trap spectra of Sn-doped α-Ga2O3 grown by halide vapor phase epitaxy on sapphire //APL Materials. – 2019. – Т. 7. – №. 5. – С. 051103.Polyakov, A. Y. ; Smirnov, N. B. ; Shchemerov, I. V.; Yakimov, E. B.; Pearton, S. J.; Ren, Fan; Chernykh, A. V.; Gogova, D.; Kochkova, A. I. Electrical properties, deep levels and luminescence related to Fe in bulk semi-insulating β-Ga2O3 doped with Fe //ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2019. – Т. 8. – №. 7. – С. Q3091.Polyakov, A. Y. ; Smirnov, N. B. ; Shchemerov, I. V.; Yakimov, E. B.; Yang, Jiancheng; Ren, F.; Yang, Gwangseok; Kim, Jihyun; Kuramata, A.; Pearton, S. J. Point defect induced degradation of electrical properties of Ga2O3 by 10 MeV proton damage //Applied Physics Letters. – 2018. – Т. 112. – №. 3. – С. 032107.Rykov, A. V. ; Dorokhin, M. V. ; Vergeles, P. S.; Baidus, N. V.; Kovalskiy, V. A.; Yakimov, E. B.; Soltanovich, O. A. Structural and optical characteristics of GaAs films grown on Si/Ge substrates //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2018. – Т. 993. – №. 1. – С. 012014.Lee, In-Hwan ; Polyakov, A. Y. ; Smirnov, N. B.; Shchemerov, I. V.; Lagov, P. B.; Zinov'ev, R. A.; Yakimov, E. B.; Shcherbachev, K. D.; Pearton, S. J. Point defects controlling non-radiative recombination in GaN blue light emitting diodes: Insights from radiation damage experiments //Journal of Applied Physics. – 2017. – Т. 122. – №. 11. – С. 115704. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Тип отзыва | Отзыв ведущей организации |
| ФИО лица, представившего отзыв | Якимов Евгений Борисович |
| Ученая степень | Доктор физико-математических наук |
| Должность | Главный научный сотрудник (Лаборатория локальной диагностики полупроводниковых материалов), |
| ФИО лица, утвердившего отзыв |  |
| Ученая степень |  |
| Должность |  |
| Полное и сокращенное наименование ведущей организации | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук  ИПТМ РАН |
| Адрес | 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6. |
| Телефон | +7 (495) 962-80-74 |
| Адрес электронной почты | general@ipmt-hpm.ac.ru |
| Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии) | http://www.iptm.ru/new/index.ru.html |